

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4812771号  
(P4812771)

(45) 発行日 平成23年11月9日(2011.11.9)

(24) 登録日 平成23年9月2日(2011.9.2)

(51) Int.Cl.

A 6 1 B 8/00 (2006.01)

F 1

A 6 1 B 8/00

請求項の数 20 (全 19 頁)

(21) 出願番号 特願2007-545185 (P2007-545185)  
 (86) (22) 出願日 平成18年10月25日 (2006.10.25)  
 (86) 国際出願番号 PCT/JP2006/321228  
 (87) 国際公開番号 WO2007/058056  
 (87) 国際公開日 平成19年5月24日 (2007.5.24)  
 審査請求日 平成21年10月2日 (2009.10.2)  
 (31) 優先権主張番号 特願2005-333797 (P2005-333797)  
 (32) 優先日 平成17年11月18日 (2005.11.18)  
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(73) 特許権者 000153498  
 株式会社日立メディコ  
 東京都千代田区外神田四丁目14番1号  
 (73) 特許権者 000005108  
 株式会社日立製作所  
 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号  
 (74) 代理人 100096091  
 弁理士 井上 誠一  
 (72) 発明者 浅房 勝徳  
 東京都千代田区外神田四丁目14番1号  
 株式会社日立メディコ内  
 (72) 発明者 永田 達也  
 茨城県ひたちなか市堀口832番地2 株式会社日立製作所機械研究所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】超音波診断装置、超音波診断装置の較正方法

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

一組の電極と前記電極間に設けられる絶縁部及び犠牲層とを有する超音波振動子を備える超音波探触子と、前記電極間にDCバイアスを印加するDCバイアス印加手段と、前記DCバイアス及び超音波送信パルスを印加することにより前記絶縁部の一部を振動させて超音波を被検体に送信する送信手段と、前記被検体から超音波エコーを受信する受信手段と、当該受信手段から出力される信号に基づき超音波像を構成する画像処理手段と、を備える超音波診断装置において、

前記電極間に絶縁部に蓄積した電荷を放電する放電手段を具備することを特徴とする超音波診断装置。

10

## 【請求項 2】

請求項1記載の超音波診断装置において、

前記放電手段は、前記電極間に放電電圧を少なくとも1回繰り返して印加することを特徴とする超音波診断装置。

## 【請求項 3】

請求項2記載の超音波診断装置において、

前記放電手段は、前記放電電圧の極性を交互に反転させて前記電極間に印加することを特徴とする超音波診断装置。

## 【請求項 4】

請求項3記載の超音波診断装置において、

20

前記放電手段は、絶対値が同じ放電電圧を前記電極間に印加することを特徴とする超音波診断装置。

**【請求項 5】**

請求項 2 記載の超音波診断装置において、

前記放電手段は、前記電極間に繰り返し印加する放電電圧の少なくとも 1 つを C o l l a p s e 電圧以上とすることを特徴とする超音波診断装置。

**【請求項 6】**

請求項 3 記載の超音波診断装置において、

前記放電手段は、前記電極間に繰り返し印加する放電電圧の印加時間を徐々に短くすることを特徴とする超音波診断装置。 10

**【請求項 7】**

請求項 2 記載の超音波診断装置において、

前記絶縁部に蓄積する電荷量を監視する監視手段を備え、

前記放電手段は、前記絶縁部に蓄積した電荷量に基づいて前記放電電圧を前記電極間に印加することを特徴とする超音波診断装置。

**【請求項 8】**

請求項 7 記載の超音波診断装置において、

前記監視手段は、前記電極間の印加される D C バイアスの印加電圧と印加時間の履歴を含む印加電圧履歴情報を保持する記憶手段を有し、

前記放電手段は、前記印加電圧履歴情報に基づいて前記放電電圧を前記電極間に印加することを特徴とする超音波診断装置。 20

**【請求項 9】**

請求項 8 記載の超音波診断装置において、

前記記憶手段は、前記電極間に印加される D C バイアスの印加電圧と印加時間との積和を保持し、

前記放電手段は、前記積和が所定の閾値に到達した場合に、前記放電電圧を前記電極間に印加することを特徴とする超音波診断装置。

**【請求項 10】**

請求項 9 記載の超音波診断装置において、

前記積和の履歴と、前記所定の閾値に対する前記積和の到達状況と、前記到達状況に基づいて前記放電手段による放電処理の要否及び時期と、のうち少なくとも 1 つを表示する表示手段を有することを特徴とする超音波診断装置。 30

**【請求項 11】**

請求項 1 記載の超音波診断装置において、

前記放電手段による前記電荷の放電を、超音波診断装置の電源 O N 又は電源 O F F 時と、前記被検体への超音波の送受信を停止している時のうち少なくとも一方で行うことを特徴とする超音波診断装置。

**【請求項 12】**

請求項 1 記載の超音波診断装置において、

前記放電手段と前記送信手段とは、パルス波形を生成するパルス波形生成手段または前記パルス波形を発生するタイミングを生成するパルスタイミング発生手段または高圧の前記パルスを出力するパルス増幅手段の少なくともいずれかを共用あるいは一部共用することを特徴とする超音波診断装置。 40

**【請求項 13】**

請求項 1 記載の超音波診断装置において、

前記放電手段は、C o l l a p s e 電圧値以下の電圧を前記電極間に印加することを特徴とする超音波診断装置。

**【請求項 14】**

請求項 1 記載の超音波診断装置において、

前記放電手段は、前記 D C バイアス印加手段とは逆極性の D C バイアス印加手段である 50

ことを特徴とする超音波診断装置。

**【請求項 15】**

請求項14記載の超音波診断装置において、

前記放電手段による前記電荷の放電中であることを報知する報知手段を備えることを特徴とする超音波診断装置。

**【請求項 16】**

請求項1記載の超音波診断装置において、

前記放電手段は、前記絶縁部の一部である振動膜に蓄積する電荷を放電させることを特徴とする超音波診断装置。

**【請求項 17】**

請求項1記載の超音波診断装置において、

超音波診断装置とは別の場所に設けられた外部制御装置との間で通信を行う通信手段を備え、

前記放電手段は、前記外部制御装置からの情報に基づいて、前記電極間の絶縁部に蓄積される電荷の放電を行うことを特徴とする超音波診断装置。

**【請求項 18】**

一組の電極と前記電極間に設けられる絶縁部及び犠牲層とを有する超音波振動子と、前記電極間にDCバイアスを印加するDCバイアス印加手段と、を備える超音波探触子を備える超音波診断装置の較正方法であって、

前記電極間に蓄積する電荷量を監視する監視ステップと、

前記電荷量に基づいて前記電極間に蓄積した電荷を放電する放電ステップと、

前記監視ステップと前記放電ステップとを繰り返すステップと、

を有することを特徴とする超音波診断装置の較正方法。

**【請求項 19】**

請求項18記載の超音波診断装置の較正方法において、前記監視ステップは、

前記電極間に印加されるDCバイアスの印加電圧と印加時間とを取得して保持する記憶ステップと、

前記印加電圧と前記印加時間との積和を演算して保持する演算ステップと、

前記積和と所定の閾値とを比較する比較ステップと、

前記積和が前記所定の閾値に到達した場合に、前記放電ステップを起動する起動ステップと、

を有することを特徴とする超音波診断装置の較正方法。

**【請求項 20】**

請求項18記載の超音波診断装置の較正方法において、

前記監視ステップと前記放電ステップとの間に、超音波診断装置とは別の場所に設けられた外部制御装置との間で、前記電荷量の情報を送受信する通信ステップを有し、

前記放電ステップは、前記外部制御装置からの情報に基づいて実行されることを特徴とする超音波診断装置の較正方法。

**【発明の詳細な説明】**

**【技術分野】**

**【0001】**

本発明は、電極間にDCバイアスを印加し超音波を送受信する超音波探触子を備える超音波診断装置及び超音波診断装置の較正方法に関する。

本出願は、日本国特許法に基づく特許出願特願第2005-333797号に基づくパリ優先権主張を伴う出願であり、特願第2005-333797号の利益を享受するため参照による援用を受ける出願である。

**【背景技術】**

**【0002】**

従来、半導体成膜技術を用いて、容量型超微細加工超音波トランステューサ(cMUT : Capacitive Micro-machined Ultrasound Tr

10

20

30

40

50

*a n s d u c e r*) が製造されている。c M U T は、微小なダイヤフラム様の装置であり、超音波信号の音響振動を変調型キャパシタンスへ変換する電極を備える。c M U T は、電極間に犠牲層を有し、この電極間に D C バイアス及び A C パルスを印加し、容量電荷を変調して電界を生じさせ、ダイヤフラムを振動させることにより超音波を発生させる。

また、c M U T の容量をキャパシタンスレギュレータにより監視して、バイアス電荷を調節する容量性マイクロマシン超音波振動子が提案されている。キャパシタンスレギュレータは、振動板電極における荷電あるいは放電に起因する微小交流電圧を測定して c M U T の容量を計測する。これにより、バイアス電荷の生成及び維持が行われる（例えば、[特許文献 1] 参照。）。

#### 【0003】

10

【特許文献 1】特表 2004 - 503312 号公報

#### 【発明の開示】

##### 【発明が解決しようとする課題】

#### 【0004】

しかしながら、c M U T は、電極間には犠牲層以外に短絡を防止する導電率  $10^{11} \sim 10^{14}$  /m 程度の振動膜と上下間隙を支持するリムを有し、電極間に D C バイアスを印加すると、電極間の振動膜及びリムに、導電率や形状等の回路上のインピーダンスに応じて寡少ではあるがリーク電流（電荷の移動）が流れるという問題点がある。

#### 【0005】

20

特に、振動膜への電荷の注入が発生すると電極間電界強度の影響により、超音波送受信感度（以下、「送受感度」という。）が経時に変化する。また、振動膜に注入された電荷は D C バイアスの印加を遮断しても振動膜中に残存する。長期間に渡る D C バイアスの印加により振動膜中に電荷が蓄積し、この振動膜中における電荷の蓄積が超音波送受信感度ドリフト（以下、「送受感度ドリフト」という。）となって送受感度歪みが生じる。送受感度歪みは、高調波成分を増大する原因となる。

#### 【0006】

また、[特許文献 1] 及び [特許文献 2] が示す技術では、電極において荷電あるいは放電が生じるが、電極間の絶縁部に注入された電荷の処理を行うものではなく、上記の送受感度ドリフトに起因する送受感度歪みを抑制することができないという問題点がある。

#### 【0007】

30

本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであり、D C バイアスの印加により電極間の絶縁部に流入した電荷の経時的蓄積に起因する送受感度ドリフトを迅速に較正する超音波診断装置を提供することを目的とする。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0008】

前述した目的を達成するために第 1 の発明は、一組の電極と前記電極間に設けられる絶縁部及び犠牲層とを有する超音波振動子を備える超音波探触子と、前記電極間に D C バイアスを印加する D C バイアス印加手段と、前記 D C バイアス及び超音波送信パルスを印加することにより前記絶縁部の一部を振動させて超音波を被検体に送信する送信手段と、前記被検体から超音波エコーを受信する受信手段と、当該受信手段から出力される信号に基づき超音波像を構成する画像処理手段と、を備える超音波診断装置において、前記電極間の絶縁部に蓄積した電荷を放電する放電手段を具備することを特徴とする超音波診断装置である。

40

#### 【0009】

超音波診断装置は、所定値の電圧を、極性を交互に反転させて少なくとも 1 回超音波振動子の電極間に印加することにより、D C バイアスの長時間印加により電極間の絶縁部に蓄積する電荷を放電する。

これにより、超音波診断装置は、電極間の絶縁部に蓄積した電荷の放電を加速させ、送受感度オフセットを急速に 0 に近づけることができる。すなわち、D C バイアスの印加により電極間振動膜に流入した電荷の経時的蓄積に起因する送受感度ドリフトを迅速に較正

50

することができる。

**【0010】**

また、前記放電手段は、Collaps電圧値以上の電圧を前記電極間に印加することにより、前記電荷の放電を加速させることが望ましい。

これにより、超音波振動子にCollaps現象が生じて犠牲層のギャップ幅が0となり、インピーダンスが急激に減少するため電荷放電速度が加速する。電荷の放電は、瞬時に行われる。

**【0011】**

第2の発明は、一組の電極と前記電極間に設けられる絶縁部及び犠牲層とを有する超音波振動子と、前記電極間にDCバイアスを印加するDCバイアス印加手段と、を備える超音波探触子を備える超音波診断装置の較正方法であって、前記電極間の絶縁部に蓄積する電荷量を監視する監視ステップと、前記電荷量に基づいて前記電極間の絶縁部に蓄積した電荷を放電する放電ステップと、前記監視ステップと前記放電ステップとを繰り返すステップと、を有することを特徴とする超音波診断装置の較正方法である。

10

**【発明の効果】**

**【0012】**

本発明によれば、DCバイアスの印加により電極間の絶縁部に流入した電荷の経時的蓄積に起因する送受感度ドリフトを迅速に較正する超音波診断装置を提供することができる。

**【図面の簡単な説明】**

20

**【0013】**

**【図1】超音波診断装置1の概略構成図（第1の実施の形態）**

**【図2】超音波探触子2が備える超音波振動子20を示す図**

**【図3】送信回路3の構成図**

**【図4】放電回路4の構成図**

**【図5】制御手段5の構成図**

**【図6】超音波振動子20の一態様を示す超音波振動子60の断面図**

**【図7】超音波振動子20の一態様を示す超音波振動子70の断面図**

**【図8】超音波送信パルス電圧及び送受感度等の関係図**

**【図9】放電処理を示すフローチャート**

30

**【図10】放電パルス電圧及び送受感度及び送受感度ドリフト等の関係図**

**【図11】印加バイアス履歴情報54及び状態遷移情報56の一態様であるテーブル110を示す図**

**【図12】表示手段10が表示する画面120の一態様を示す図**

**【図13】超音波診断装置1aの概略構成図（第2の実施の形態）**

**【図14】超音波診断装置1bの概略構成図（第3の実施の形態）**

**【図15】超音波診断装置1c及び外部制御装置153の概略構成図（第4の実施の形態）**

**【符号の説明】**

**【0014】**

40

1、1a、1b、1c ..... 超音波診断装置

2 ..... 超音波探触子

3、3a ..... 送信回路

4、4a、80 ..... 放電手段

5 ..... 制御手段

6、6b ..... DCバイアス回路

7 ..... 送受分離回路

8 ..... 受信回路

9 ..... 画像処理手段

10 ..... 表示手段

50

2 0 、 6 0 、 7 0	.....超音波振動子	
2 1 、 6 1 、 7 1	.....上部電極	
2 2	.....振動膜	
2 3	.....リム	
2 4 、 6 2 、 7 2	.....下部電極	
2 5 、 6 4 、 7 4	.....犠牲層	
2 7	.....ギャップ幅	
3 1	.....超音波送信パルスタイミング発生手段	
3 2	.....超音波送信パルス波形生成手段	
3 3	.....超音波送信パルサ	10
4 1	.....放電パルスタイミング発生手段	
4 2	.....放電パルス波形生成手段	
4 3	.....放電パルサ	
5 1	.....演算部	
5 2	.....主メモリ	
5 3	.....記憶部	
5 4	.....印加バイアス履歴情報	
5 5	.....放電パルス波形情報	
5 6	.....状態遷移情報	
6 3 、 7 3	.....絶縁部	20
6 9 、 7 9	.....電荷注入	
1 5 1 、 1 5 5	.....通信部	
1 5 2	.....ネットワーク	
1 5 3	.....外部制御装置	
1 5 4	.....リモートメンテナンスセンタ	
1 5 9	.....履歴情報	
1 6 0	.....記憶部	

【発明を実施するための最良の形態】

【0015】

以下添付図面を参照しながら、本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態について詳細に説明する。尚、以下の説明及び添付図面において、略同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略することにする。

【0016】

(1. 超音波診断装置1の構成)

最初に、図1～図5を参照しながら、本発明の第1の実施の形態に係る超音波診断装置1について説明する。

【0017】

(1-1. 超音波診断装置1の概略構成)

図1は、超音波診断装置1の概略構成図である。

超音波診断装置1は、超音波探触子2、送信回路3、放電手段4、制御手段5、DCバイアス回路6、送受分離回路7、受信回路8、画像処理手段9、表示手段10から構成される。

第1の実施の形態の超音波診断装置1では、送信回路3及び放電手段4の各出力を結合して送受分離回路7へ出力する構成を探る。

【0018】

超音波診断装置1は、超音波探触子2により被検体に対して超音波を送受信し、画像処理手段9により画像処理を行い、表示手段10に被検体の撮像画像を出力する。超音波診断装置1は、超音波探触子2が備える超音波振動子20の電極間にDCバイアスを印加することにより電界を発生させ、超音波送信パルスを印加することにより振動膜を振動させて被検体に超音波を送信し、被検体からの超音波エコーによる振動膜の振動を検出して超

音波を受信する。

**【0019】**

超音波探触子2には、DCバイアス回路6及び送受分離回路7が接続される。送受分離回路7には、送信回路3及び受信回路8及び放電手段4が接続される。受信回路8には、表示手段10を備える画像処理手段9が接続される。DCバイアス回路6、送信回路3、放電手段4、受信回路8、画像処理手段9は、制御手段5に接続される。

**【0020】**

送信回路3は、送受分離回路7に超音波送信パルスを送信する回路である。放電手段4は、超音波振動子20の電極間の絶縁部に注入された電荷を放電させる装置である。DCバイアス回路6は、超音波探触子2の超音波振動子20に印加するDCバイアスを制御する回路である。送受分離回路7は、超音波送信パルスと超音波受信パルスとを分離する回路である。

受信回路8は、送受分離回路7からの超音波送信パルスを受信する回路である。画像処理手段9は、受信回路8から送られた受信信号に対して検波処理等を行って超音波像を再構成する演算装置である。表示手段10は、画像処理手段9から送られた超音波像を表示するモニタ等の表示装置である。

制御手段5は、超音波診断装置1の状態及び各装置を制御する装置である。

**【0021】**

(1-2.超音波振動子20)

図2は、超音波探触子2が備える超音波振動子20を示す図である。

尚、図2に示す超音波振動子20はcMUT(Capacitive Micro-machined Ultrasound Transducer)を示す。

**【0022】**

超音波振動子20は、上部電極21、可撓性の絶縁材料からなる振動膜22、振動膜22の周囲を支持する窒化珪素(Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>)等の絶縁材料からなるリム23、下部電極24、上部電極21～下部電極24間に形成される真空ギャップ層である犠牲層25により構成される。犠牲層25のギャップ幅27は、電極間に印加されるDCバイアスや振動膜22の振動により変化する。尚、「絶縁部」は、上部電極21～下部電極24間に振動膜22及びリム23を含むものとして説明する。

**【0023】**

超音波振動子20は、それを駆動する駆動信号に重畠して印加されるバイアス電圧の大きさに応じて超音波送受信感度が変化する振動子である。超音波振動子20により超音波を送受するとき、その超音波振動子20に所定のバイアスを印加して振動子の電気機械結合係数を変化させることにより、超音波振動子20の送受信感度を所定の値に合わせている。

上部電極21と下部電極24との間に適切な電圧信号を印加すると、超音波振動子20は、容量型超音波トランスデューサセルとして機能する。超音波エコー信号をセンサ部(振動膜22及び犠牲層25)の運動エネルギー変化として捕捉しこれに伴う電流値変化を検知することによって受信電気信号が得られる。

**【0024】**

(1-3.送信回路3)

図3は、送信回路3の構成図である。

送信回路3は、クロックカウンタ等を備える超音波送信パルスタイミング発生手段31と、セレクタ及びメモリ及びメモリ制御部等を備える超音波送信パルス波形生成手段32と、クロック分周器及びバッファ及びレベルシフタ及びパワードライバ等を備える超音波送信パルサ33とから構成される。

**【0025】**

送信回路3は、制御手段5により、中心周波数(例えば0.1MHz～数十MHz)及び波数及びエンベロープ等による波形生成、繰り返し周波数及び送波フォーカス用遅延量等による発生タイミング、增幅率、電源電圧等による出力強度が制御される

10

20

30

40

50

## 【0026】

(1 - 4 . 放電回路4)

図4は、放電回路4の構成図である。

放電回路4は、クロックカウンタ等を備える放電パルスタイミング発生手段41と、セレクタ及びメモリ及びメモリ制御部等を備える放電パルス波形生成手段42と、クロック分周器及びバッファ及びレベルシフタ及びパワードライバ等を備える放電パルサ43とから構成される。

## 【0027】

放電手段4は、制御手段5により、中心周波数（例えば数Hz～数十kHz）、波数による波形生成、放電トリガ及び電荷蓄積量等による発生タイミング、増幅率、電源電圧などによる出力強度が制御される。

10

## 【0028】

放電パルスタイミング発生手段41は、制御手段5によりクロック分周比率及びクロックカウンタ数等が制御され、放電パルス発生タイミング信号を生成する。

放電パルス波形生成手段42は、制御手段5により中心周波数及び波数及びエンベロープ等の条件設定に応じてセレクタを選択する。メモリ制御部は、セレクタにより選択された状態に応じてアドレス設定及び波形データの読み書きを行ってメモリを制御し、かつ、放電パルスタイミング発生手段41の放電パルス発生タイミング信号発生時に放電パルス波形を生成する。

放電パルサ43は、放電パルス波形生成手段42により生成した放電パルス波形をバッファによりバッファリングし、レベルシフタによりレベルシフトすることにより増幅し、パワードライバにより超音波探触子2の各超音波振動子20の電極間に放電パルスを印加する。

20

## 【0029】

図5は、制御手段5の構成図である。

制御手段5は、CPU等の演算部51、RAM等の主メモリ52、ハードディスク等の記憶部53から構成される。

記憶部53は、印加バイアス履歴情報54及び放電パルス波形情報55、状態遷移情報56を保持する。

## 【0030】

30

印加バイアス履歴情報54は、超音波振動子20の電極間に印加したバイアスの履歴に関する情報（印加電圧値及び印加時間等）であり、Logファイル等の形態を探ることができる。

放電パルス波形情報55は、放電手段4が生成する放電パルス波形に関する情報であり、Configファイル等の形態を探ることができる。

状態遷移情報56は、通常の超音波送受信処理状態と蓄積した電荷を放電する放電処理状態との間の状態遷移に関する情報であり、Stateファイルやフラグ等の形態を探ることができる。

## 【0031】

制御手段5は、主メモリ52に印加バイアス履歴情報54及び放電パルス波形情報55及び状態遷移情報56を一旦呼び出す。演算部51は、印加バイアス履歴情報54に基づき放電パルス波形情報55の条件に応じて、放電パルス波形の波形情報としてパルス数及び各パルスの印加電圧及び印加時間（図10(b)の波高値 $v_h$  ( $t_h$ ) 及び放電時間 $t_h$ 等）を算出する。制御手段5は、状態遷移情報56により状況に応じて超音波送受信処理状態と放電処理状態とを遷移させ、超音波探触子2の各超音波振動子20の電極間にある振動膜22に蓄積した電荷を放電させる。

40

## 【0032】

(2 . 電荷注入)

次に、図6及び図7を参照しながら、電極間の絶縁部への電荷注入について説明する。

## 【0033】

50

図6は、超音波振動子20の一態様を示す超音波振動子60の断面図である。

超音波振動子60は、半導体プロセスによる微細加工により形成される。超音波振動子60は、上部電極61、下部電極62、絶縁部63、犠牲層64、基板65から構成される。絶縁部63は、膜体66、枠体67、膜体68から構成される。絶縁部63は、シリコン化合物等の絶縁材料からなる。犠牲層64は、真空状態あるいは所定のガスが充填される。

#### 【0034】

DCバイアスが印加されると、上部電極61と下部電極62との間には電界が生じる。絶縁部63は高抵抗であるが、電極間に電界が生じることにより、絶縁部63に微小電流が流れ、上部電極61及び下部電極62から絶縁部63に対して電荷注入69が発生する。  
10 DCバイアスの印加が遮断されると、上部電極61及び下部電極62の電荷はなくなるが、絶縁部63に注入した電荷はそのまま滞留して蓄積される。電荷蓄積量は、DCバイアスの印加電圧と印加時間の積和に比例する。

#### 【0035】

絶縁部63の一部は、振動膜を形成する。絶縁部63の振動膜の部分に電荷注入が発生して電荷が蓄積されると、電極間電界強度の影響により、送受感度が変化する。また、電荷蓄積が送受感度ドリフトとなって送受感度歪みが生じる。

#### 【0036】

図7は、超音波振動子20の一態様を示す超音波振動子70の断面図である。

超音波振動子70は、上部電極71、下部電極72、絶縁部73、犠牲層74から構成される。絶縁部73は、膜体76、枠体77、膜体78から構成される。図7の上部電極71及び絶縁部73及び犠牲層74は、図6の上部電極61及び絶縁部63及び犠牲層64と同様のものである。図7の下部電極72は、図6の基板65を下部電極として用いたものである。  
20

#### 【0037】

図7の超音波振動子70においても、図6の超音波振動子60と同様に、上部電極71及び下部電極72から絶縁部73に対して電荷注入79が発生する。

#### 【0038】

##### (3. 送受感度ドリフト)

次に、図8を参照しながら、送受感度ドリフトについて説明する。  
30

図8は、超音波送信パルス電圧及び送受感度等の関係図である。

#### 【0039】

図8(a)は、超音波送信パルス電圧と送受感度との関係を示すグラフである。横軸は超音波送信パルス電圧 $v_s$ を示し、縦軸は送受感度 $p(v_s)$ を示す。

図8(b)は、超音波送信パルス電圧と時間との関係を示すグラフである。横軸は超音波送信パルス電圧 $v_s(t_s)$ を示し、縦軸は超音波送信時間 $t_s$ を示す。

図8(c)は、超音波送信時間と送受感度との関係を示すグラフである。横軸は超音波送信時間 $t_s$ を示し、縦軸は送受感度 $p(t_s)$ を示す。

#### 【0040】

超音波振動子20の電極間にDCバイアスを印加した時間が比較的短時間の場合、超音波送信パルス電圧と送受感度との関係はグラフ201に示される。グラフ201は、原点202を通る直線である。グラフ203に示すような極性±に同振幅の超音波送信パルス電圧 $v_s$ (ACパルス)を印加すると、グラフ204に示すように、送受感度 $p(t_s)$ は、極性±に偏り及び歪みがない。  
40

#### 【0041】

一方、超音波振動子20の電極間にDCバイアスを印加した時間が長時間の場合、超音波振動子20の振動膜22に電荷が注入されると、送受感度極性の偏りすなわち、送受感度ドリフト205が生じる。送受感度ドリフト205が生じると、超音波送信パルス電圧と送受感度との関係はグラフ206に移行する。グラフ206は、原点202を通らない。グラフ203に示すような極性±に同振幅の超音波送信パルス電圧 $v_s$ (ACパルス)  
50

を印加すると、グラフ 207 に示すように、送受感度  $p(t_s)$  は、極性  $\pm$  に偏り及び歪みが生じる。この送受感度歪みは、高調波成分が増大する原因となる。

#### 【0042】

##### (4. 超音波診断装置1の放電処理)

次に、図9～図11を参照しながら、超音波診断装置1の放電処理について説明する。

本発明の超音波診断装置1は、Collapsing 現象及びSnapback 現象を用いて、超音波振動子20の電極間に蓄積した電荷を短時間に放電することを特徴とする。

##### (4-1. Collapsing 現象及びSnapback 現象)

超音波振動子20の電極間に印加するDCバイアスの大きさが所定の範囲内であれば、振動膜22の弾性力とDCバイアス印加によるクーロン力とのつり合いにより犠牲層25のギャップ幅27が所定幅となり平衡状態となる。

一方、超音波振動子20の電極間に印加するDCバイアスが大きくなるに伴いクーロン力が大きくなり、犠牲層25のギャップ幅27がより小さくなっている状態で平衡となる。

さらに、超音波振動子20の電極間に印加するDCバイアスが所定範囲を超えて大きくなると、振動膜22の弾性力がDCバイアス印加によるクーロン力を支えきれなくなり不balanceが発生し、犠牲層25のギャップ幅27が急激に減少して0となる。この現象及び状態は、それぞれ、「Collapsing 現象」及び「Collapsing 状態」と呼ばれる。Collapsing 状態が発生する印加電圧の閾値は、「Collapsing 電圧」と呼ばれる。

#### 【0043】

Collapsing 現象が発生していない状態では、振動膜22及びリム23のインピーダンスとDCバイアス印加電圧の比に応じて、絶縁部に電荷の注入が発生する。

一方、Collapsing 状態では、振動膜22のみのインピーダンスとDCバイアス印加電圧との比に応じて、電荷の注入が発生する。Collapsing 状態では、インピーダンスが急激に減少するため電荷注入速度が加速する。

#### 【0044】

また、Collapsing 状態からDCバイアス印加電圧を小さくすると、クーロン力が小さくなるのでCollapsing 現象とは逆の現象が生じ、犠牲層25のギャップ幅が0から、急激に所定幅まで変化する。この現象は「Snapback 現象」と呼ばれる。Snapback 現象が発生する印加電圧の閾値は「Snapback 電圧」と呼ばれる。

すなわち、Collapsing 現象が生じると、振動膜22の弾性力とクーロン力との間で不balanceが生じるが、振動膜22の弾性特性が失われることはない。従って、Snapback 現象が生じると、振動膜22の弾性力とクーロン力との間で平衡状態が復活する。

Snapback 現象後は、振動膜22及びリム23のインピーダンスに対するDCバイアス印加電圧の比に応じて、電荷の注入が発生する。

#### 【0045】

##### (4-2. 放電処理の詳細)

図9は、放電処理を示すフローチャートである。

図10は、放電パルス電圧及び送受感度及び送受感度ドリフト等の関係図である。

#### 【0046】

図10(a)は、放電パルス電圧と送受感度との関係を示すグラフである。横軸は放電パルス電圧  $v_h$  を示し、縦軸は送受感度  $p(v_h)$  を示す。

図10(b)は、放電パルス電圧と時間との関係を示すグラフである。横軸は放電パルス電圧  $v_h$  ( $t_h$ ) を示し、縦軸は放電時間  $t_h$  を示す。

図10(c)は、放電時間と送受感度ドリフトとの関係を示すグラフである。横軸は放電時間  $t_h$  を示し、縦軸は送受感度ドリフト  $p_d(t_h)$  を示す。

#### 【0047】

超音波診断装置1が超音波送信処理を継続することにより、超音波振動子20の電極21と電極24との間の絶縁部に、DCバイアス印加電圧の極性の電荷が蓄積する(ステップ101)。

10

20

30

40

50

制御手段 5 は、DC バイアスの印加電圧及び印加時間に関する情報を計測し、印加バイアス履歴情報 5 4 に記録する（ステップ 102）。制御手段 5 は、DC バイアスの印加電圧及び印加時間の積和が所定の基準値に到達したか否かを判定する。所定の基準値に到達した場合（ステップ 103 の Yes）、ステップ 104 以降の放電処理に移行する。

#### 【0048】

放電手段 4 は、注入された電荷を放電するために、通常の DC バイアス印加電圧の極性と逆極性の放電パルス（H<sub>1</sub>）を所定時間（t<sub>0</sub> ~ t<sub>1</sub>）超音波振動子 20 の電極間に印加する（ステップ 104）。尚、所定時間（t<sub>0</sub> ~ t<sub>1</sub>）は、状態のばらつきを考慮して、僅かに逆電荷が注入される程度の時間とすることが望ましい。

放電パルス（H<sub>1</sub>）の波高値（v<sub>h</sub>（t<sub>h</sub>））は、Collaps 電圧以上であり、  
Collaps 現象が発生する。犠牲層 25 のギャップ幅 27 が 0 となり、電荷の放電が加速される（ステップ 105）。

#### 【0049】

次に、放電手段 4 は、残存した逆電荷を放電するために、前回の放電パルス（H<sub>1</sub>）の極性と逆極性の放電パルス（H<sub>2</sub>）を所定時間（t<sub>1</sub> ~ t<sub>2</sub>）超音波振動子 20 の電極間に印加する（ステップ 106）。尚、所定時間（t<sub>1</sub> ~ t<sub>2</sub>）は、状態のばらつきを考慮して、僅かに逆電荷が注入される程度の時間とすることが望ましい。また、所定時間（t<sub>0</sub> ~ t<sub>1</sub>） > 所定時間（t<sub>1</sub> ~ t<sub>2</sub>）、とすることが望ましい。

放電パルス（H<sub>2</sub>）の波高値（v<sub>h</sub>（t<sub>h</sub>））は、Collaps 電圧以上であり、Collaps 現象が発生する。犠牲層 25 のギャップ幅 27 が 0 となり、電荷の放電が加速される（ステップ 107）。

#### 【0050】

放電手段 4 は、ステップ 104 及びステップ 105 の処理を所定の回数繰り返すと（ステップ 108）、放電パルス（H）の印加を終了する（ステップ 109）。好ましくは、印加時間を徐々に短くし、所定時間（t<sub>0</sub> ~ t<sub>1</sub>） > 所定時間（t<sub>1</sub> ~ t<sub>2</sub>） > ... > 所定時間（t<sub>m-1</sub> ~ t<sub>m</sub>） > 所定時間（t<sub>m</sub> ~ t<sub>m+1</sub>）、とする。

超音波振動子 20 の電極間の印加電圧が Collaps 電圧以下となると、Snap back 現象が生じ、犠牲層 25 のギャップ幅 27 が所定幅に回復する（ステップ 110）。送受感度ドリフト（pd（t<sub>h</sub>））は、略「0」に収束する。

#### 【0051】

図 10 を参照すると、極性を反転させた放電パルス（H）の印加を 4 回繰り返した例が示されている。放電手段 4 が放電パルス（H<sub>1</sub>）を超音波振動子 20 の電極間に印加すると、送受感度ドリフト pd（t<sub>0</sub>）から送受感度ドリフト pd（t<sub>1</sub>）に移行する。同様にして、放電手段 4 が順に放電パルス（H<sub>2</sub>） 放電パルス（H<sub>3</sub>） 放電パルス（H<sub>4</sub>）を超音波振動子 20 の電極間に印加すると、送受感度ドリフト pd（t<sub>2</sub>） 送受感度ドリフト pd（t<sub>3</sub>） 送受感度ドリフト pd（t<sub>4</sub>）に移行する。送受感度ドリフト pd（t<sub>4</sub>）は、略「0」に集束する。

#### 【0052】

尚、極性反転放電パルスの印加回数は、少なくとも 1 回以上とする。超音波探触子 2 は、多数の超音波振動子 20 により構成される。各超音波振動子 20 の特性にはばらつきがあるので、1 回の逆極性放電パルス印加では、全ての超音波振動子 20 について同時に送受感度ドリフトを 0 にすることは困難である。1 回の逆極性放電パルス印加により、ある程度の送受感度ドリフトを改善することができるが、図 9 及び図 10 に示すように、極性反転放電パルスを複数回印加することにより送受感度ドリフトを 0 に収束させることが望ましい。

また、図 9 のステップ 104 ~ ステップ 109 及び図 10 に示す放電処理は、1 秒以下の短時間で終了する。従って、放電処理を行うタイミングは、電源 ON / 電源 OFF 時又は超音波の送受信を停止している時（Freeze 時）とすることが望ましい。

#### 【0053】

このように、第 1 の実施の形態では、超音波診断装置 1 は、放電手段 4 により、極性を

10

20

30

40

50

交互に反転させて C o l l a p s e 電圧以上の波高値の放電パルスを超音波振動子 2 0 の電極間に複数回印加し、超音波振動子 2 0 の振動膜 2 2 に蓄積した電荷の放電を加速させ、送受感度オフセットを急速に 0 に近づけることができる。電荷の放電は、瞬時に行われる。すなわち、D C バイアスの印加により電極間の絶縁部に流入した電荷の経時的蓄積に起因する送受感度ドリフトを迅速に較正することができる。

#### 【 0 0 5 4 】

##### ( 4 - 3 . 電荷蓄積の監視 )

図 1 1 は、印加バイアス履歴情報 5 4 及び状態遷移情報 5 6 の一態様であるテーブル 1 1 0 を示す図である。

テーブル 1 1 0 には、日付 1 1 1 、時刻 1 1 2 、印加時間 1 1 3 、印加電圧 1 1 4 、積和 1 1 5 、状態 1 1 6 の各項目が記録される。日付 1 1 1 、時刻 1 1 2 、印加時間 1 1 3 、印加電圧 1 1 4 、積和 1 1 5 は、図 5 の印加バイアス履歴情報 5 4 に相当する。状態 1 1 6 は、図 5 の状態遷移情報 5 6 に相当する。

#### 【 0 0 5 5 】

日付 1 1 1 及び時刻 1 1 2 は、D C バイアスの印加日時を示す。印加時間 1 1 3 は、D C バイアスの印加時間を示し、例えば、「 2 h 」である。印加電圧 1 1 4 は、D C バイアスの印加電圧を示し、例えば、「 1 0 0 V 」である。積和 1 1 5 は、前回の放電処理後の D C バイアスの印加電圧と印加時間との積和を示し、例えば、「 2 0 0 V · h 」である。状態 1 1 6 は、電荷蓄積状況や放電処理の実行状況を示す。状態 1 1 6 には、例えば、所定の基準値（例えば、「 3 0 0 0 0 V · h 」）に対する積和 1 1 5 の到達率が記録される。

#### 【 0 0 5 6 】

制御手段 5 は、図 9 のステップ 1 0 2 の処理において、テーブル 1 1 0 の日付 1 1 1 、時刻 1 1 2 、印加時間 1 1 3 、印加電圧 1 1 4 、積和 1 1 5 の記録を行う。制御手段 5 は、図 9 のステップ 1 0 3 の処理において、テーブル 1 1 0 の積和 1 1 5 が所定の基準値に到達したか否かを判断し、所定の基準値に到達したと判断した場合（ステップ 1 0 3 の Yes ）、図 9 のステップ 1 0 4 以降の放電処理を実行する。制御手段 5 は、テーブル 1 1 0 に基づいて放電処理の実行タイミングや、図 1 0 ( b ) に示す放電パルス ( H ) の波形情報（パルス数及び各パルスの印加電圧及び印加時間）を算出し、電極間に放電パルスを印加する。

これにより、放電処理の開始タイミングを適切に決定することができる。

#### 【 0 0 5 7 】

##### ( 4 - 4 . D C バイアス印加履歴及び状態の表示 )

図 1 2 は、表示手段 1 0 が表示する画面 1 2 0 の一態様を示す図である。

表示手段 1 0 は、印加バイアス履歴情報 5 4 及び状態遷移情報 5 6 に基づいて、電荷蓄積状況をグラフ表示する。

画面 1 2 0 は、縦軸が D C バイアスの印加電圧と印加時間との積和を示し、横軸が日時を示す。時点 1 2 1 では、D C バイアスの印加電圧と印加時間との積和が所定の基準値 1 2 2 に到達したので、放電処理が行われる。また、現時点 1 2 3 における所定の基準値 1 2 2 に対する積和の到達率 1 2 4 を表示するようにしてもよい。さらに、放電処理の要否を表示するようにしてもよい。

これにより、電荷蓄積量や放電処理の要否及び時期を把握することができる。尚、制御手段 5 が放電処理開始のタイミングを判断して自動的に放電処理を実行するものとして説明したが、放電スイッチ等を装置本体に設けて手動操作により放電処理を実行するようにしてもよい。この場合、表示手段 1 0 が表示する上記到達率や放電処理の要否に基づいて、手動操作による放電処理を実行することが望ましい。

#### 【 0 0 5 8 】

##### ( 5 . 第 2 の実施の形態 )

次に、図 1 3 を参照しながら、第 2 の実施の形態に係る超音波診断装置 1 a について説明する。

10

20

30

40

50

図13は、超音波診断装置1aの概略構成図である。

#### 【0059】

第1の実施の形態の超音波診断装置1では、放電手段4を単独に構成するものとして説明したが、第2の実施の形態の超音波診断装置1aでは、送信回路3aと放電手段4aとの間で、パルスタイミング発生手段やパルス波形生成手段やパルサを共用あるいは一部共用される。例えば、送信回路3aは、放電手段4を包含する構成とすることができます。

#### 【0060】

第2の実施の形態では、第1の実施の形態と同様に、超音波診断装置1aは、放電手段4aにより、極性を交互に反転させてC011apse電圧以上の波高値の放電パルスを超音波振動子20の電極間に複数回印加し、超音波振動子20の振動膜22に蓄積した電荷の放電を加速させ、送受感度オフセットを急速に0に近づけることができる。10

#### 【0061】

また、第2の実施の形態では、送信回路3aと放電手段4aとの間で構成要素を一部共用するので、装置構成を簡素化することができる。

#### 【0062】

##### (6. 第3の実施の形態)

次に、図14を参照しながら、第3の実施の形態に係る超音波診断装置1bについて説明する。

図14は、超音波診断装置1bの概略構成図である。

#### 【0063】

第1の実施の形態の超音波診断装置1では、放電手段4を単独に構成するものとして説明したが、第3の実施の形態の超音波診断装置1bでは、放電手段80は、DCバイアス回路6b内に包含される。20

放電手段80を包含するDCバイアス回路6bにより、超音波振動子20の電極間に印加するDCバイアス値を変動させることにより、超音波振動子20の振動膜22に蓄積した電荷の放電を加速させる。

超音波診断装置1bでは、第1の実施の形態及び第2の実施の形態のようなC011apse電圧以上の放電パルスに代えて、記憶部53の印加バイアス履歴情報54に基づいて、C011apse電圧以下の逆極性のDCバイアスを印加することにより、超音波振動子20の振動膜22に注入した電荷を放電することができる。30

#### 【0064】

第3の実施の形態では、放電手段80を包含するDCバイアス回路6bにより、逆極性のC011apse電圧以下のDCバイアスを印加することにより、超音波振動子20の振動膜22に蓄積した電荷の放電を加速させ、送受感度オフセットを迅速に0に近づけることができる。

尚、C011apse電圧以下のDCバイアスを印加する場合、放電処理時間は、数時間に渡って継続する。従って、キーボードやモニタ等の操作機器に放電処理を起動するスイッチを設けると共に、放電処理の実行中であることを示す表示や警報等の報知手段を設けることが望ましい。

#### 【0065】

また、第3の実施の形態では、放電処理用のパルスタイミング発生手段やパルス波形生成手段やパルサを設ける必要がないので装置構成を簡素化することができる。

尚、C011apse電圧以上のDCバイアスを印加することにより蓄積電荷の放電処理を行うことも理論的には可能であるが、逆極性のC011apse電圧以上のDCバイアスを印加すると、逆に電荷注入が進行して送受感度ドリフトが増大する可能性があるので、逆極性のC011apse電圧以下のDCバイアス電圧をゆっくりと印加して放電させる方が簡単確実で安全上も好ましい。

#### 【0066】

##### (7. 第4の実施の形態)

次に、図15を参照しながら、第4の実施の形態に係る超音波診断装置1cについて説

50

明する。

図15は、超音波診断装置1c及び外部制御装置153の概略構成図である。

#### 【0067】

第1の実施の形態では、超音波診断装置1自身が放電処理のタイミングや放電パルス波形情報を算出して放電処理を実行するものとして説明したが、第4の実施の形態では、外部制御装置153により放電処理のタイミングや放電パルス波形情報を算出する。

#### 【0068】

超音波診断装置1cは、ネットワーク152を通して、リモートメンテナンスセンタ154に属する外部制御装置153と接続される。超音波診断装置1cは、図1の超音波診断装置1と同様のものである。外部制御装置153は、履歴情報取得手段156及びパラメータ更新手段157及び放電処理指示手段158及び記憶部160を備える。外部制御装置153は、パーソナルコンピュータ等の端末装置である。ネットワーク152は、簡易型携帯電話等の無線通信回線やインターネット等のネットワーク回線である。超音波診断装置1c及び外部制御装置153は、それぞれ、通信部151及び通信部155を備え、通信部151及びネットワーク152及び通信部155を通して相互に情報を授受することができる。

#### 【0069】

超音波診断装置1cと外部制御装置153との間では、一定間隔あるいは使用状況に応じて間欠的に履歴情報159が送受信される。履歴情報159は、電極間のDCバイアスの印加履歴や放電パルスの印加履歴を含む。履歴情報159の送受信に関しては、超音波診断装置1cが能動的に外部制御装置153に履歴情報159を送信するか、あるいは、外部制御装置153が能動的に超音波診断装置1cから履歴情報159を取得する。

#### 【0070】

外部制御装置153は、履歴情報取得手段156により、超音波診断装置1cが記憶部53に保持する履歴情報159を取得して記憶部160に保持する。外部制御装置153は、履歴情報159に基づいて超音波診断装置1cの絶縁部電荷の充放電状態を確認する。

また、外部制御装置153は、パラメータ更新手段157により、放電パルス波形の波高値、所定時間、回数等を生成するためのパラメータや、状態遷移の条件判断のパラメータ等の情報を確認すると共に、必要に応じて、これらのパラメータの更新値を超音波診断装置1cに送信して更新させる。

さらに、外部制御装置153は、放電処理指示手段158により、放電処理を超音波診断装置1cに指令して実行させる。

#### 【0071】

超音波診断装置1cは、外部制御装置153から送信された放電処理に関するパラメータや放電処理指令に基づいて、これらのパラメータの更新や放電処理を実行する。また、超音波診断装置1cは、パラメータの更新結果や放電処理の実行結果を外部制御装置153に送信する。

#### 【0072】

このように、第4の実施の形態では、外部制御装置153から超音波診断装置1cにおける放電処理に関するパラメータの更新や放電処理のタイミングを制御することができる。また、ネットワーク152に複数の超音波診断装置1cを接続することにより、複数の超音波診断装置1cにおける放電処理を1台の外部制御装置153により一元管理することができる。

#### 【0073】

##### (8. その他)

上述の実施の形態では、Collapse現象及びSnapback現象を用いて、DCバイアスの長時間印加により超音波振動子の振動膜に注入された電荷を迅速に放電することについて説明したが、MEMS(Micro Electro Mechanical System)技術を用いたメカリレー等によるシャントスイッチを超音波振動子に

10

20

30

40

50

内装することにより、振動膜の電荷を放電することができる。この場合、シャントスイッチの開閉を制御することにより、電荷の放電を行うことができる。

【 0 0 7 4 】

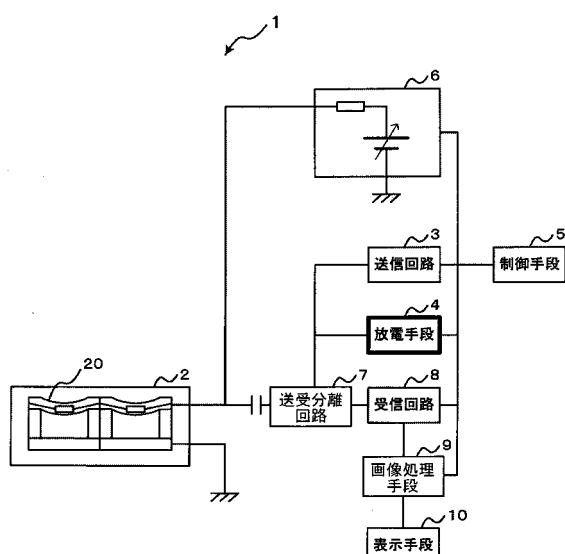
また、制御手段5は、超音波送受信処理状態と放電処理状態との間の状態遷移を監視し、超音波診断装置1の操作者に処理状態を通知するようにしてもよい。例えば、表示手段10へのアラート表示や音情報等により、放電処理実行中の旨を超音波診断装置1の操作者に通知するようにしてもよい。

【 0 0 7 5 】

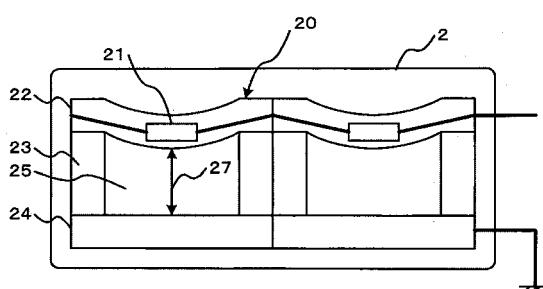
以上、添付図面を参照しながら、本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態について説明したが、本発明はかかる例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。

10

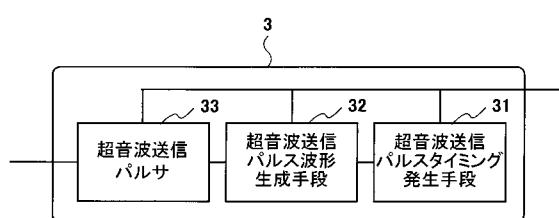
【 义 1 】



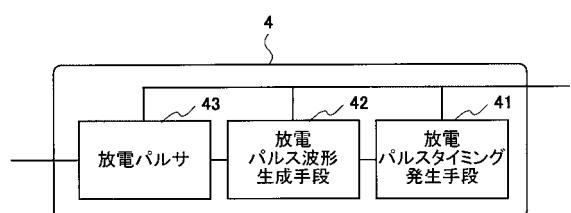
( 义 2 )



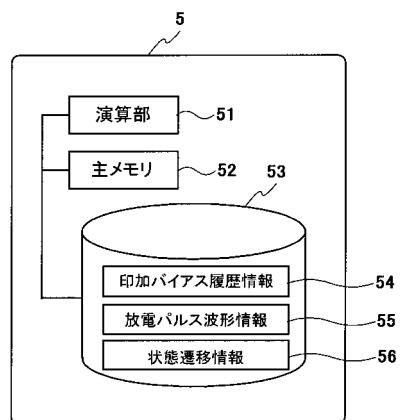
【图3】



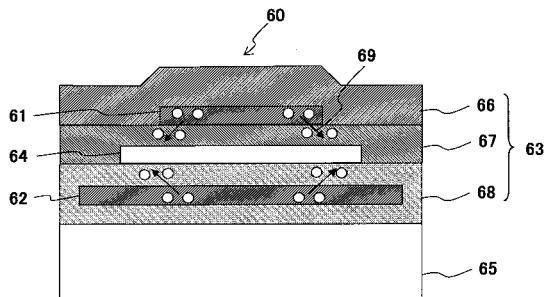
【図4】



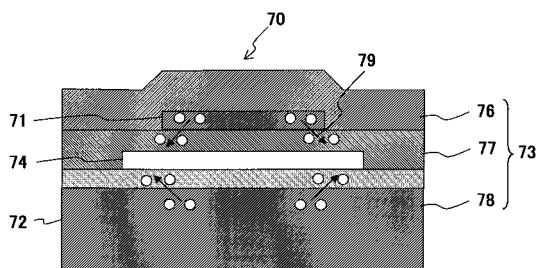
【図5】



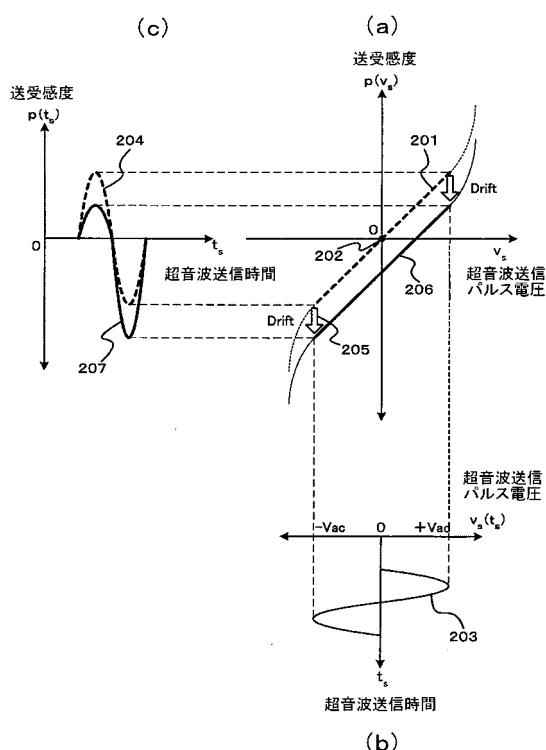
【図6】



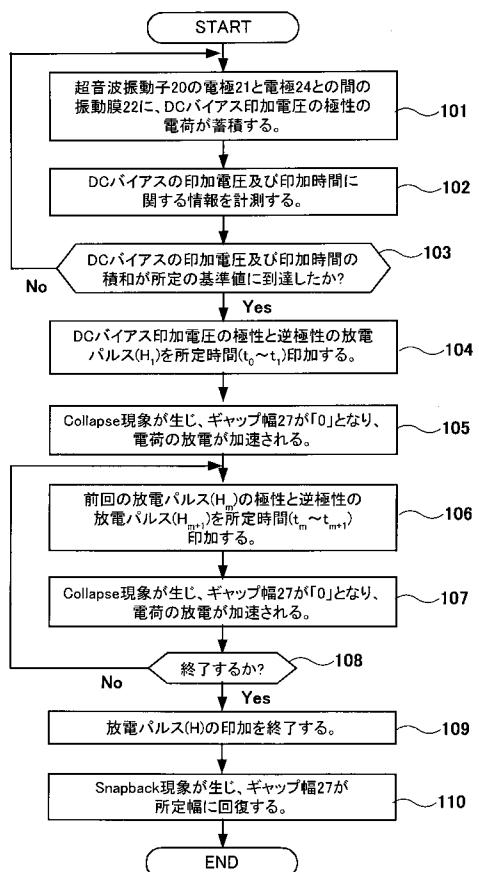
【図7】



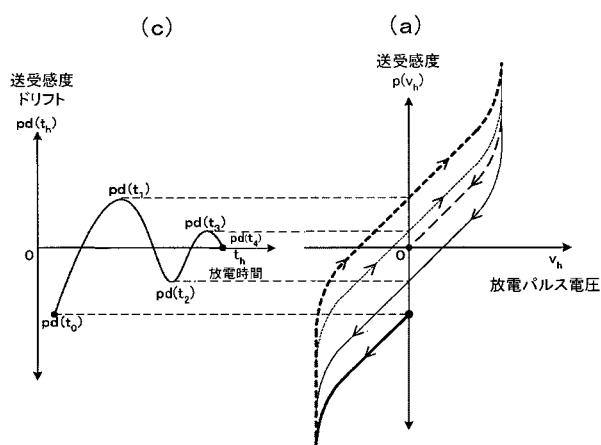
【図8】



【図9】



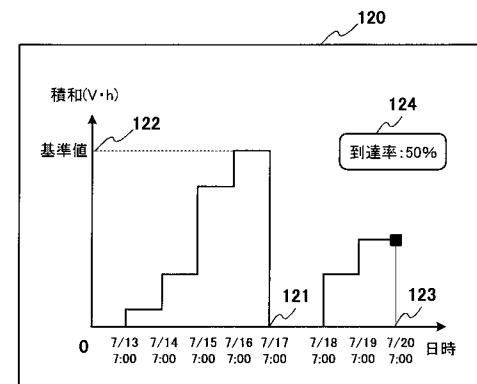
【図10】



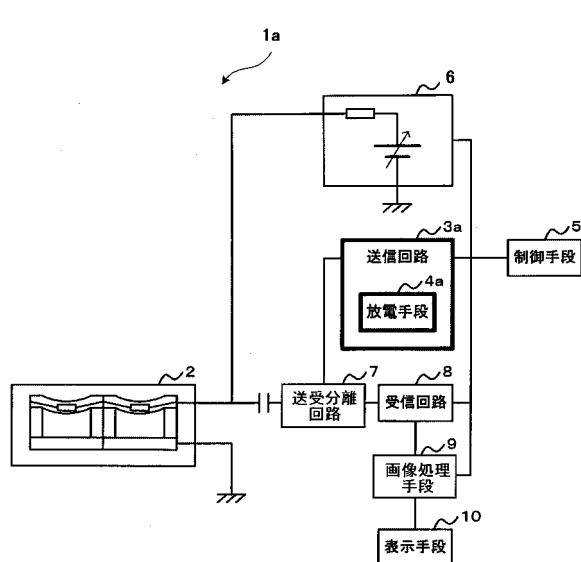
【図11】

		110	54	56	
111	112	113	114	115	116
日付	時刻	印加時間	印加電圧	積和	状態
2006/9/12	10:00～12:00	2h	100V	200V·h	0.67%
2006/9/13	9:30～17:30	8h	100V	1000V·h	3.33%
:	:	:	:	:	:
2006/12/14	10:00～17:00	7h	100V	30000V·h	100%
2006/12/14	17:30	—	—	—	放電
2006/12/15	10:00～13:00	3h	100V	300V·h	1.00%
:	:	:	:	:	:

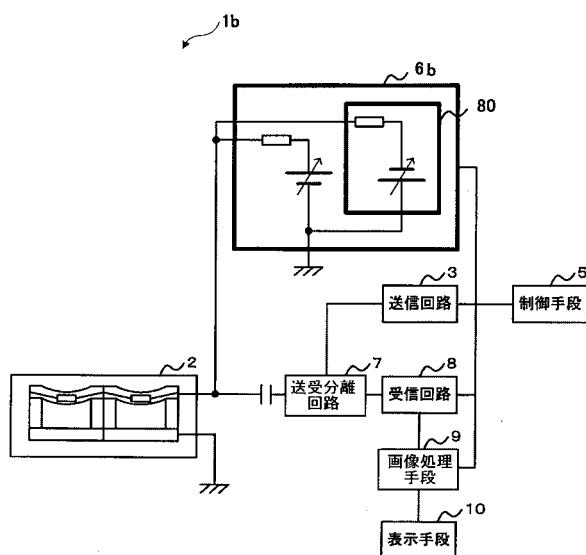
【図12】



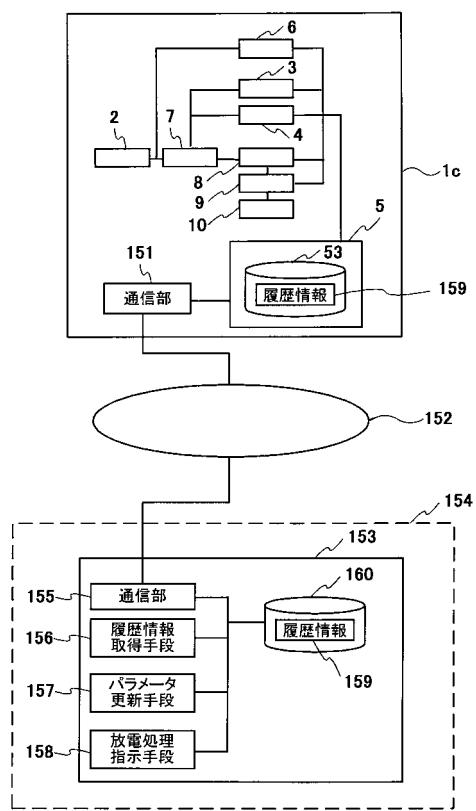
【図13】



【図14】



【図15】



---

フロントページの続き

審査官 右 高 孝幸

(56)参考文献 特表2004 - 503312 ( J P , A )

Baris Bayram et al , Capacitive Micromachined Ultrasonic Transducer Design for High Power Transmission , IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control , 2005年 2月 , vol. 52, no. 2 , pp.326-339

(58)調査した分野(Int.Cl. , DB名)

A61B 8/00

专利名称(译)	超声波诊断装置，超声波诊断装置的校准方法		
公开(公告)号	<a href="#">JP4812771B2</a>	公开(公告)日	2011-11-09
申请号	JP2007545185	申请日	2006-10-25
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立医药 株式会社日立制作所		
申请(专利权)人(译)	株式会社日立メディコ 株式会社日立制作所		
当前申请(专利权)人(译)	株式会社日立メディコ 株式会社日立制作所		
[标]发明人	浅房勝徳 永田達也		
发明人	浅房 勝徳 永田 達也		
IPC分类号	A61B8/00		
CPC分类号	G01N29/343 A61B8/4483 A61B8/58 B06B1/0207 B06B1/0292 G01N29/0654 G01N29/2406 G01N29/4427		
FI分类号	A61B8/00		
代理人(译)	井上清一		
优先权	2005333797 2005-11-18 JP		
其他公开文献	JPWO2007058056A1		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

## 摘要(译)

## 【図2】

超声波诊断装置1使放电装置4多次在超声波换能器20的电极之间施加放电脉冲（峰值等于或大于塌陷电压），同时每次反转放电脉冲的极性，从而加速在超声波换能器20的振动膜中累积的电荷的放电，从而可以使发送-接收灵敏度偏移快速接近零。电荷瞬间放电。也就是说，可以快速校准在向其施加DC偏压时流入电极之间的隔膜的电荷的时间累积产生的发送-接收灵敏度漂移。

